

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ

Козырев А.В., Семенюк Н.С. Критерии и динамика электрического пробоя газонаполненного диода на левой ветви кривой Пашена	5
Юшков Г.Ю., Гридилов В.Г. Немонотонная зависимость плотности плазмы от давления газа магнетронного разряда с мишенью из бора	12

ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ

Маркова А.А., Садовников С.А., Герасимова М.П., Яковлев С.В., Крючков А.В., Кравцова Н.С., Кистенев Ю.В. Использование узкополосного лазерного диода в задачах дистанционного газоанализа атмосферы	21
--	----

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Киреева И.В., Чумляков Ю.И., Победенная З.В., Федорова А.В. Твердорастворное упрочнение атомами азота монокристаллов $(\text{CrFeMn})_{60}\text{Co}_{35}\text{Ni}_{4.8}\text{N}_{0.2}$ высокоэнтропийного сплава	29
Степанов Н.П., Грабко Г.И. Релаксационные процессы в природном пирите, происходящие под воздействием постоянных и переменных электрических полей	37
Левин Ю.К. Методика расчета давления нанопузыря в воде	45
Мялинский А.Ю., Барышников С.В., Стукова Е.В. Диэлектрические и тепловые свойства композитов на основе иодида диизопропиламмония и микрочастиц меди	50
Ивченко В.А. Полевая ионная микроскопия структурной модификации поверхности ЖСЗ6-ВИ после бомбардировки Ar^+ (30 кэВ)	57
Давыдов Р.В., Гольдберг А.А., Проводин Д.С., Давыдов В.В., Дудкин В.И. О влиянии поля модуляции и частотного сдвига спинового взаимодействия на формирование сигналов поглощения и дисперсии ядерного магнитного резонанса при их регистрации в слабых полях	65

ФИЗИКА МАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Беляев Б.А., Сержантов А.М., Бальва Я.Ф., Лексиков А.А., Крёков С.Д., Поминов К.И., Бурлаков И.Е. Высокоизбирательный полосно-пропускающий фильтр для входного мультиплексора спутниковой связи С-диапазона	79
--	----

ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ

Новиков П.Л., Павский К.В., Цынк П.Н. Моделирование димеризации атомов на поверхности структурированных подложек Si	87
Хахулин С.А., Коляда Д.В., Фирсов Д.Д., Комков О.С., Тимофеев В.А., Скворцов И.В., Машанов В.И., Гайдук А.Е., Уткин Д.Е. Влияние прямоугольных алюминиевых нанополос на оптическое излучение множественных квантовых ям GeSiSn/Si	95

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Мусин А.И., Самойлов В.Н. Влияние атомов поверхности грани (001) Au на коэффициент ионного распыления: сравнение с теорией Зигмунда	103
--	-----